

本期封面



1999年3期

栏目:

DOI:

论文题目: 压痕诱发单晶Si非晶化相变区的三维空间分布结构

作者姓名: 吴亚桥 徐永波

工作单位: 中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室, 沈阳 110015

通信作者: 吴亚桥

通信作者Email: lais@imr.ac.cn

文章摘要: 利用航向电子显微术 (TEM) 观察了单晶Si 维氏压痕区的结构转变. 平视和截面像相结合给出了压痕诱导Si 非晶化的轮廓图. 其区域为与压头相似的倒四棱锥金字塔形. 但其棱边夹角小于相对应的压头相对棱夹角, 残留的准确无误痕深度很浅.

关键词: 非晶化相变 压痕 空间分布 单晶硅

分类号: 0613.72

关闭